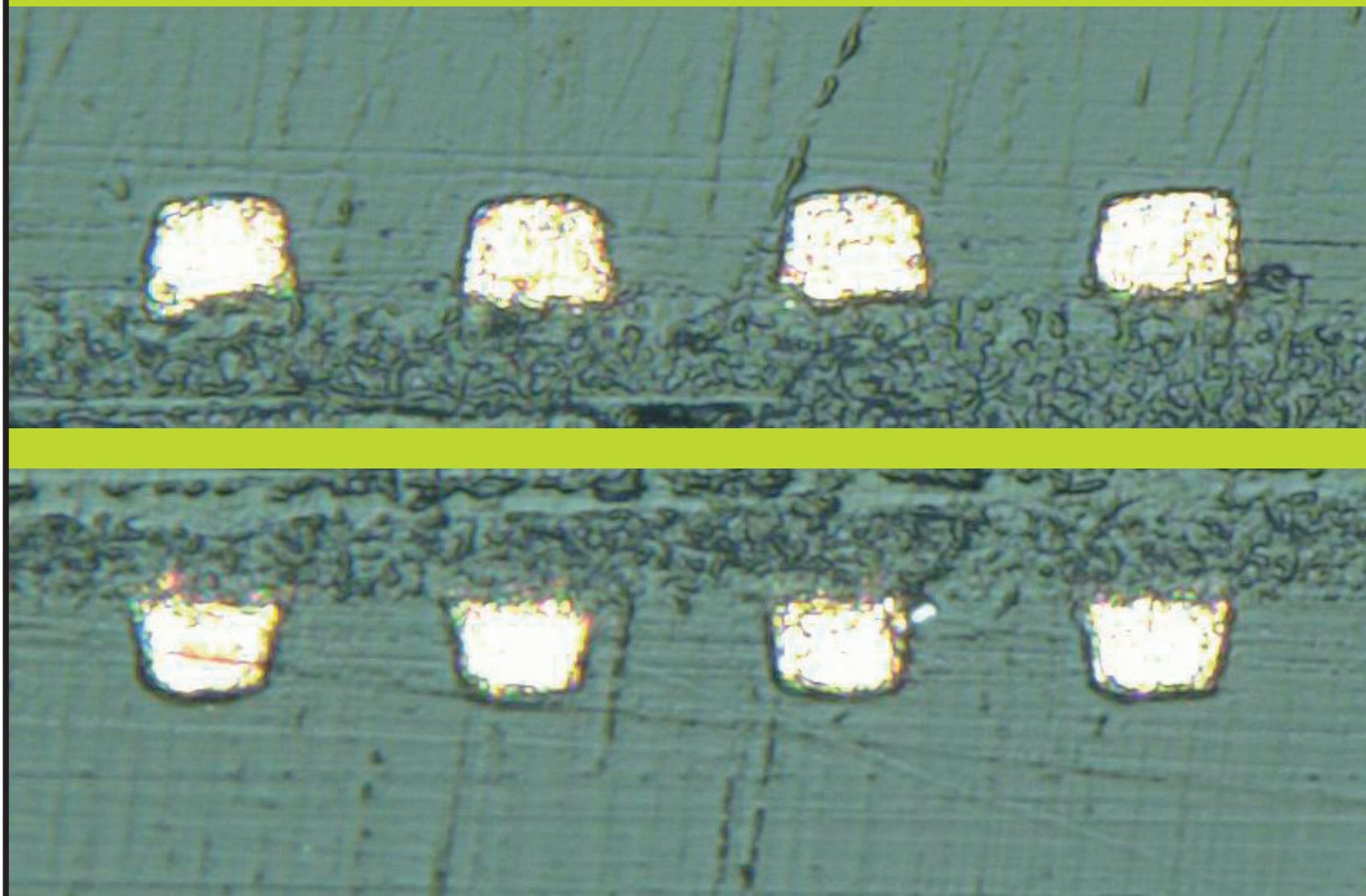


ハイブリッドエッチング装置 (Hybrid etching equipment)

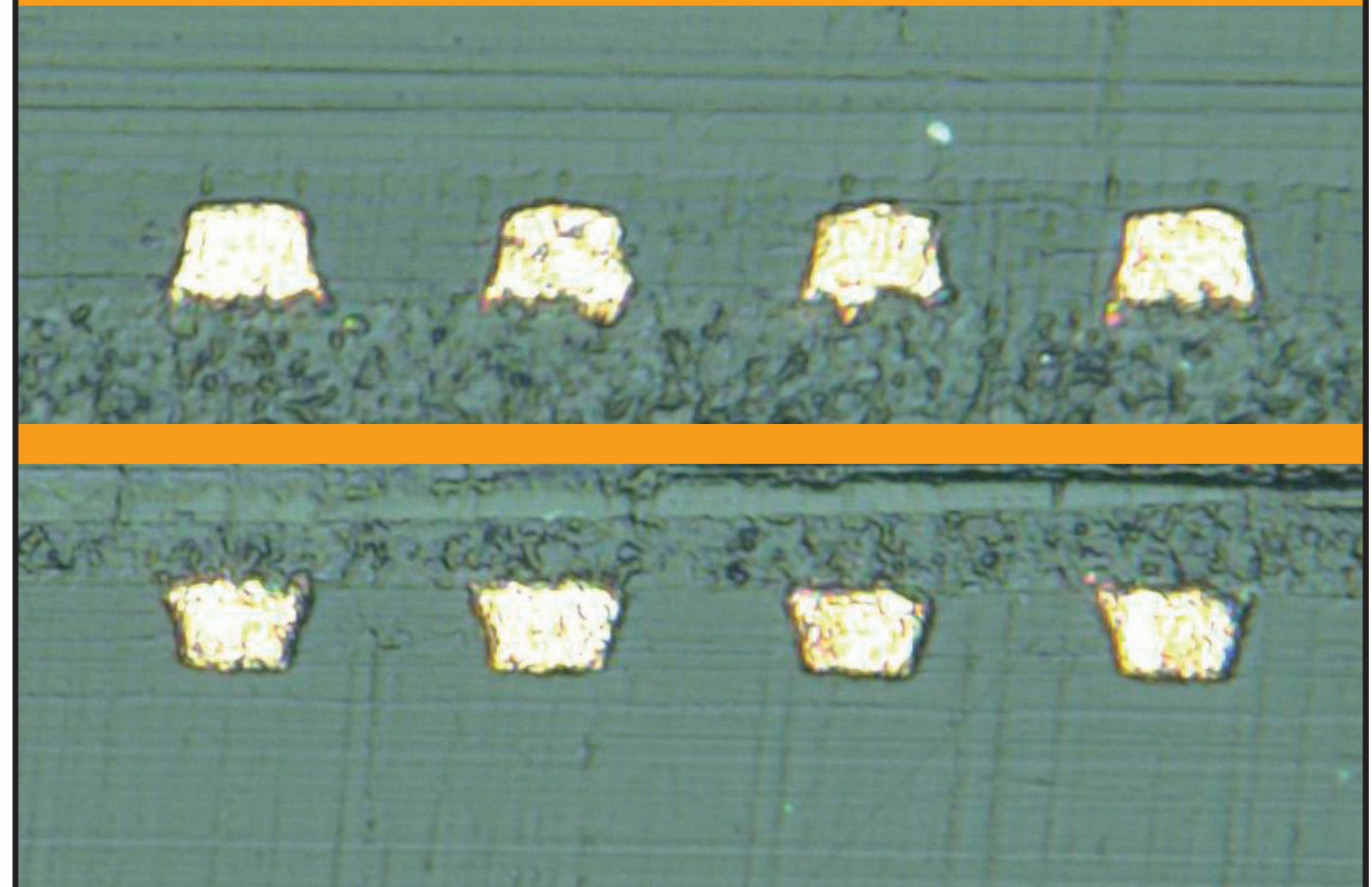
Line/space/Cu thickness = 20 μ m/20 μ m/12 μ m

基板周辺部断面



平均	上面	下面
膜厚	12.5 μ m	12.4 μ m
Top	17.3 μ m	16.0 μ m
Bottom	20.2 μ m	19.6 μ m
E. F	8.6	6.9

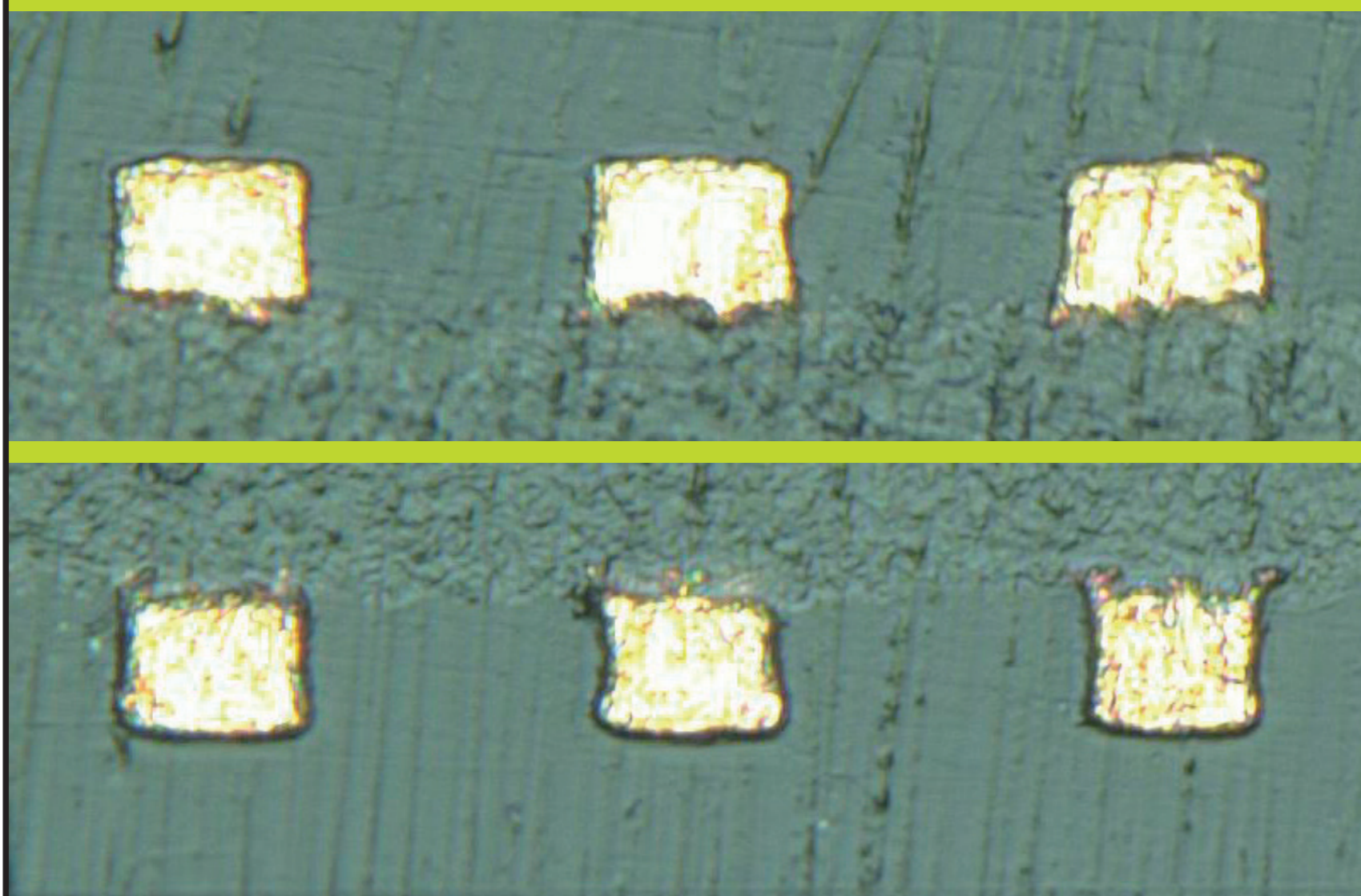
基板中央部断面



平均	上面	下面
膜厚	11.2 μ m	12.4 μ m
Top	14.7 μ m	15.5 μ m
Bottom	19.0 μ m	18.7 μ m
E. F	5.2	7.8

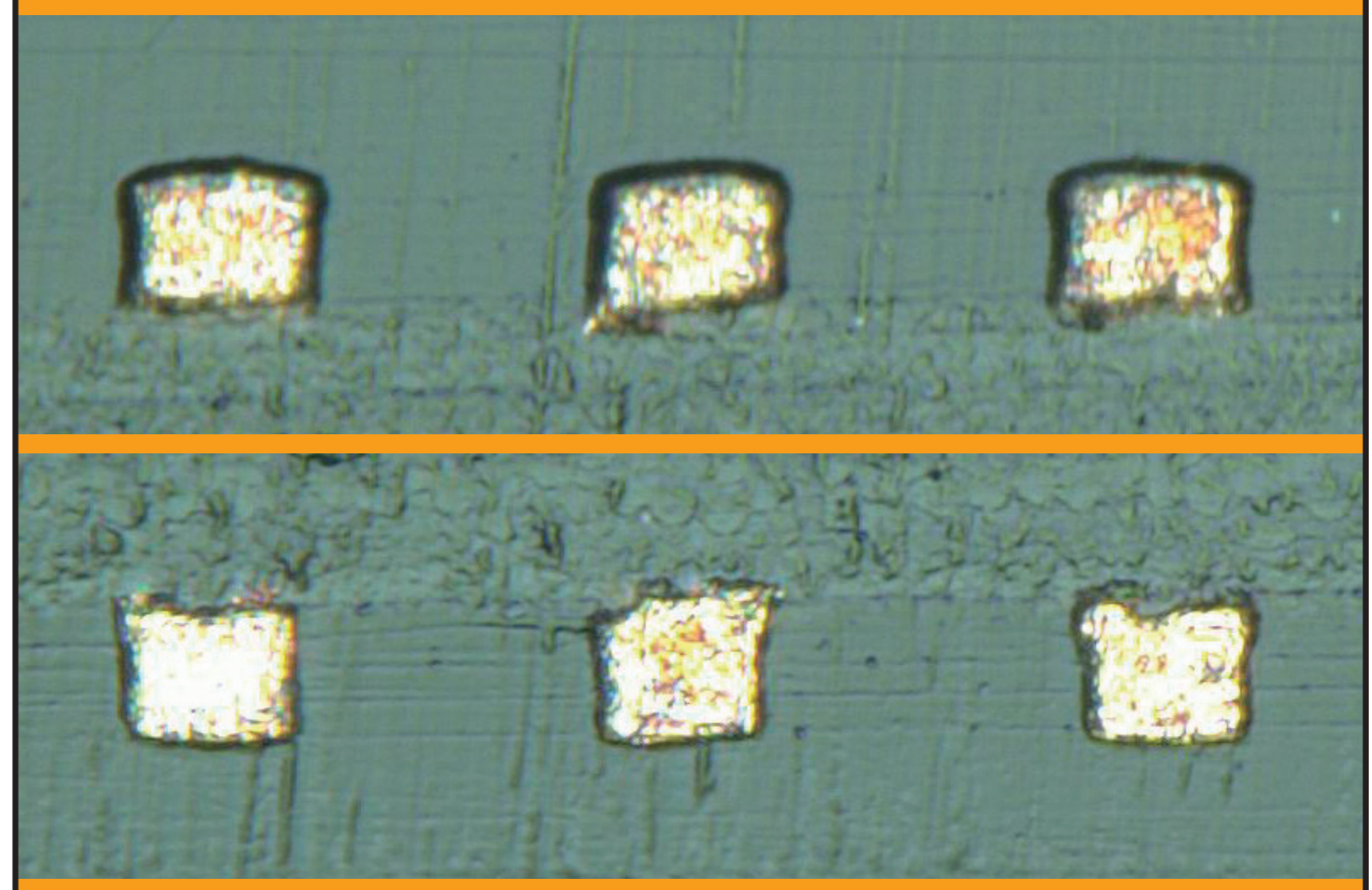
Line/space/Cu thickness = 30 μ m/30 μ m/18 μ m

基板周辺部断面



平均	上面	下面
膜厚	18.4 μ m	17.7 μ m
Top	24.6 μ m	22.3 μ m
Bottom	27.6 μ m	24.6 μ m
E. F	12.3	15.4

基板中央部断面



平均	上面	下面
膜厚	18.6 μ m	17.3 μ m
Top	20.0 μ m	21.0 μ m
Bottom	22.7 μ m	24.4 μ m
E. F	13.8	10.2